

Содержание

• Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Давыдов С.Ю.

Об адсорбции атомов натрия на грани (111) германия . . . 865

• Электронные и оптические свойства полупроводников

Никитина А.Г., Зуев В.В.

Выявление особенностей локализации электронов на U^- -центрах в полупроводниках методом термостимулированных токов 869

Маслов А.Ю., Прошина О.В.

Влияние спектра элементарных возбуждений на спиноподобный распад полупроводниковых твердых растворов . . . 873

Рабенок Е.В., Гапанович М.В., Новиков Г.Ф., Один И.Н.

Влияние самокомпенсации на время жизни электрона в теллуриде кадмия, легированном галлием 878

Смирнов М.С., Овчинников О.В., Латышев А.Н., Смирнова А.М., Новиков П.В., Ефимова М.А.

Центры сенсibilизированной антистоксовой люминесценции в кристаллах $AgCl$ 884

Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Вайполин А.А., Боднарь И.В., Осипова М.А., Ушакова Т.Н.

Фоточувствительные структуры на монокристаллах ZnP_2 моноклинной и тетрагональной модификаций: получение и свойства 890

• Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Агеев О.А., Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Иванов В.Н., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Литвин П.М., Миленин В.В., Саченко А.В.

Диоды с барьером Шоттки $Au-TiB_x-n-6H-SiC$: особенности токопереноса в выпрямляющих и невыпрямляющих контактах 897

Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Иванов В.Н., Капитанчук Л.М., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Литвин О.С., Миленин В.В., Шеремет В.Н., Свешников Ю.Н.

Радиационные эффекты в многослойных омических контактах $Au-Ti-Al-Ti-n-GaN$ 904

Красильникова Л.В., Степихова М.В., Байдакова Н.А., Дроздов Ю.Н., Красильник З.Ф., Чалков В.Ю., Шенгуров В.Г.

Оптически активные центры в гетероструктурах $Si/Si_{1-x}Ge_x:Er$, связанные с ионами Er^{3+} 909

Александров О.В., Козловский В.В.

Моделирование взаимодействия никеля с карбидом кремния при формировании омических контактов 917

Набиев Г.А.

Определение механизмов генерации фотонапряжения в полупроводниковых пленках с помощью спектральных зависимостей коэффициента поглощения и фотонапряжения . . . 924

Набиев Г.А.

О механизмах эффекта аномально больших фотонапряжений в пленках $CdTe$ 926

• Низкоразмерные системы

Моргунов Р.Б., Дмитриев А.И., Мушенко Ф.Б., Казакова О.Л.

Спин-орбитальное взаимодействие носителей заряда с примесями в ориентированных нанопроволоках $Ge_{0.99}Me_{0.01}$ ($Me = Mn, Cr, Co, Fe$) 928

Смирнов А.М., Оsepцова В.А., Платонов А.В., Гуревич А.С., Кочерешко В.П., Школьник А.С., Евтихий В.П., Петров В.В., Долгих Ю.К., Ефимов Ю.П., Елисеев С.А.

Анизотропия спиновой релаксации электронов, вызванная конкуренцией механизмов Рашбы и Дрессельхауза 933

Сошников И.П., Цырлин Г.Э., Надточий А.М., Дубровский В.Г., Букин М.А., Петров В.А., Бусов В.В., Трошков С.И.

Свойства $GaAsN$ нитевидных нанокристаллов, полученных методом магнетронного осаждения 938

Козырев С.П.

ИК-спектроскопия решеточных колебаний и сравнительный анализ сверхрешеток $ZnTe/CdTe$ с квантовыми точками на подложке $GaAs$ с буферными слоями $ZnTe$ и $CdTe$. . . 943

• Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Ременюк А.Д., Звонарева Т.К., Захарова И.Б., Толмачев В.А., Беляков Л.В., Перова Т.С.

Исследование оптических свойств аморфного углерода, модифицированного платиной 947

Воронков Э.Н., Козюхин С.А.

Электропроводность аморфных пленок халькогенидных соединений в сильных электрических полях 953

Болотов В.В., Стенькин Ю.А., Росликов В.Е., Кан В.Е., Пономарева И.В., Несов С.Н.

Влияние этанола на оптические и электрофизические параметры пористого кремния 957

Демидов Е.С., Добычин Н.А., Карзанов В.В., Марычев М.О., Сдобняков В.В.

Электронный парамагнитный резонанс и фотолюминесценция в пиролитических пленках нитрида кремния при ионном облучении аргоном и молекулярным азотом 961

● **Физика полупроводниковых приборов**

Верховцева А.В., Гергель В.А.

Динамика локального микропробоя в гейгеровском режиме работы лавинных фотодиодов 966

Tsai Jung-Hui, Chlu Shao-Yen, Lour Wen-Shiung, Guo Der-Feng

High-performance InGaP/GaAs *pnp* δ -doped heterojunction bipolar transistor 971

Калыгина В.М., Тяжев А.В., Яскевич Т.М.

Твердотельные преобразователи изображения на основе структур GaAs/ZnS 975

Ионычев В.К., Ребров А.Н.

Исследование глубоких центров в микроплазменных каналах кремниевых лавинных эпитаксиальных диодов 980

Васильев П.В., Любутич С.К., Пономарев А.В., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Цыранов С.Н., Чолах С.О.

Работа полупроводникового прерывателя при микросекундном времени накачки и низкой плотности тока 985

Рукин С.Н., Цыранов С.Н.

Численное моделирование процесса субнаносекундного обрыва тока в мощных полупроводниковых диодах 989

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Лундин В.В., Сахаров А.В., Заварин Е.Е., Синицын М.А., Николаев А.Е., Михайловский Г.А., Брунков П.Н., Гончаров В.В., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Цацульников А.Ф.

Влияние несущего газа и профиля легирования на морфологию поверхности сильно легированных слоев GaN:Mg, выращенных методом МО ГФЭ 996

Сенников П.Г., Голубев С.В., Шашкин В.И., Пряхин Д.А., Дроздов М.Н., Андреев Б.А., Дроздов Ю.Н., Кузнецов А.С., Польш Х.-Й.

Получение слоев нанокристаллического кремния плазмохимическим осаждением из газовой фазы тетрафторида кремния 1002